

Title (en)

Process for producing a double layer with hetero-junction for the memory electrode of an image registration device.

Title (de)

Verfahren zum Herstellen einer Doppelschicht mit Hetero-Übergang für die Speicherelektrode einer Bildaufnahmeverrichtung.

Title (fr)

Procédé de fabrication d'une double couche avec hétéro-jonction pour l'électrode à mémoire d'un dispositif de prise de vue.

Publication

EP 0031095 A2 19810701 (DE)

Application

EP 80107832 A 19801211

Priority

DE 2951482 A 19791220

Abstract (en)

[origin: US4359488A] A double layer having a hetero-junction interface for a storage electrode of an electro-optical camera device is produced by vacuum vapor deposition of n-conductive cadmium selenide or cadmium sulfo-selenide onto a n+-conductive signal electrode layer comprised of tin oxide. The cadmium material to be vapor deposited is admixed with a small amount of a glass additive, such as boron oxide, the admixture sintered in vacuum and thereafter the cadmium material is vapor-deposited onto the signal electrode without spattering. The resultant hetero-junction is substantially free of metallic cadmium and such double layer is particularly useful in a Vidicon target.

Abstract (de)

Eine Doppelschicht mit Hetero-Übergang soll Teil einer Speicherelektrode für eine optoelektronische Bildaufnahmeverrichtung sein. Sie entsteht durch Aufdampfen von n-leitendem Cadmiumselenid oder Cadmium sulfoselenid auf eine n<+>-leitende Signalelektrodenschicht aus Zinnoxid. Das aufzudampfende Material wird unter geringem Zusatz von Boroxid-Glas im Vakuum gesintert und kann dann spritzerfrei aufgedampft werden. Der Hetero-Übergang ist nahezu frei von metallischem Cadmium. Anwendung insbesondere bei einem Vidikon-Target.

IPC 1-7

H01J 9/233; **H01J 29/45**

IPC 8 full level

G03G 5/08 (2006.01); **H01J 9/233** (2006.01); **H01J 29/36** (2006.01); **H01J 29/45** (2006.01); **H01L 21/203** (2006.01); **H01L 31/04** (2006.01); **H01L 31/18** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01J 9/233 (2013.01 - EP US); **H01J 29/456** (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0031095 A2 19810701; **EP 0031095 A3 19820428**; **EP 0031095 B1 19841205**; DE 2951482 A1 19810702; DE 2951482 C2 19830105; JP S56116678 A 19810912; JP S6146069 B2 19861011; US 4359488 A 19821116

DOCDB simple family (application)

EP 80107832 A 19801211; DE 2951482 A 19791220; JP 17964580 A 19801217; US 21236780 A 19801203